МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет електроніки та інформаційних технологій

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Кваліфікаційна робота бакалавра ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЕМ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СТРУКТУРИ І ФАЗОВОГО СКЛАДУ ФЕРОМАГНІТНИХ ПЛІВКОВИХ НАНОСТРУКТУР

спеціальності 171 Електроніка

Здобувач вищої освіти гр. ЕП-81

Науковий керівник

канд. фіз.-мат. наук, доцент

Завідувач кафедри ЕЗПФ

д-р фіз.-мат. наук, професор

В.І. Жаботинський

І.М. Пазуха

I. Ю. Проценко

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики Спеціальність 171 – Електроніка, освітньо-професійна програма «Електронні інформаційні системи»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ЕЗПФ

І.Ю.Проценко

«25» травня 2022 року

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Жаботинського Владислава Ігоревича

1. Тема роботи <u>Використання методу ПЕМ при дослідженні</u> <u>структури і фазового складу феромагнітних плівкових наноструктур</u>

затверджена наказом по університету від «04» травня 2022 р., № 0316-VI

2. Термін здачі студентом закінченої роботи <u>08 червня 2022 року</u>

3. Вихідні дані до роботи (актуальність, мета)

Бурхливий розвиток різних галузей плівкового матеріалознавства (мікро- і наноелектроніка, мікроприладобудування, сенсорна техніка) виступає постійним стимулом розвитку необхідної експериментальної техніки. Просвічуюча електронна мікроскопія є сьогодні одним із потужних методів дослідження, який плідно використовується у фізиці, хімії, матеріалознавстві, біології, медицині, техніці. Мова йде насамперед про сучасні методи просвічуючої і растрової електронної мікроскопії високої розрізнювальної здатності, про методи аналізу хімічного та елементного складу плівкових матеріалів. Мета роботи полягає у вивченні особливостей аналізу кристалічної структури та фазового складу тонкоплівкових матеріалів при використанні методу просвічуючої електронної мікроскопії.

<u>Мета кваліфікаційної роботи полягає в дослідженні кристалічної структури та фазового стану феромагнітних плівкових наноструктур, сформованих на основі пермалоєвого сплаву Ni₈₀Fe₂₀ та Au методами електронографії та просвічуючої електронної мікроскопії.</u>

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить їх розробити)

1. Конструкція та принцип роботи просвічуючого електронного мікроскопа, режими роботи.

2. Використання методу ПЕМ при дослідженні феромагнітних плівкових наноструктур.

3. Методика підготовки зразків для проведення електронно-мікроскопічних досліджень.

4. Експериментальні результати.

5. Висновки.

5. Перелік графічного мате ріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) Слайди № 1-2 – Загальна інформація

Слайди № 3-5 – Конструкція та принцип роботи просвічуючого електронного мікроскопа, режими роботи

Слайди № 6-7 – Використання методу ПЕМ при дослідженні феромагнітних плівкових наноструктур

Слайди № 8-9 – Методика експерименту

Слайди № 10-11 – Експериментальні результати

Слайд № 12 – Висновки

6. Дата видачі завдання <u>26.05.2022 р.</u>

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

N⁰	Назва етапів кваліфікаційної роботи магістрів	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1.	Аналіз літературних даних	до 30.05.2022 р.	вик.
2.	Конструкція та принцип роботи просвічуючого електронного мікроскопа, режими роботи	до 04.06.2022 р.	вик.
3.	Аналіз дифракційних картин та мікрознімків кристалічної структури досліджуваних систем	до 06.06.2022 р.	вик.
4.	Підготовка тексту магістерської	до 08.06.2022 р.	вик.
5.	Попередній захист роботи	10.06.2022 р., 10 ⁰⁵ (дистанційно)	вик.
6.	Захист роботи в екзаменаційній комісії	16.06.2022 р., 17.06. 2022 р., 10 ⁰⁵ (дистанційно)	вик.

Здобувач вищої освіти

В.І. Жаботинський

Керівник роботи

I.М. Пазуха

РЕФЕРАТ

Мета кваліфікаційної роботи бакалавра досліджені полягала В кристалічної фазового феромагнітних плівкових структури та стану наноструктур, сформованих на основі пермалоєвого сплаву Ni₈₀Fe₂₀ та Au методами електронографії та просвічуючої електронної мікроскопії.

Під час виконання роботи були використані методи електронографії при дослідження дифракційної картини та просвічуючої електронної мікроскопії при дослідженні кристалічної структури. Зразки осаджувалися у вакуумній камері ВУП-5М за допомогою методики одночасного електронно-променевого випарування при кімнатній температурі та тиску залишкових газів 10⁻⁴ Па. Досліди проводилися на приприладі ПЕМ-125К в режимах дифракції та світлого поля.

Показано, що фазовий склад феромагнітної нанорозмірної плівкової системи (Ni₈₀Fe₂₀ + Au)/П є двофазним та відповідає ГЦК-Ni₃Fe + ГЦК-Au із параметрам ґратки $a(\Gamma$ ЦК-Ni₃Fe) = 0,3548 нм та $a(\Gamma$ ЦК-Au) = 0,4069 нм, що відповідає комбінації фаз складових компонент системи. Перерозподіл інтенсивностей на електронограмі відбувається внаслідок накладання ліній $d_{200}(Ag)$ і $d_{111}(Ni_3Fe)$ та $d_{311}(Ag)$ і $d_{220}(Ni_3Fe)$. Кристалічна структуру зразка (Ni₈₀Fe₂₀+Au)/П є нанорозмірною з середнім розміром зерна L = 10-12 нм. Це пов'язано з тим що внаслідок реалізації методу одночасні конденсації відбувається сповільнення росту зерен немагнітної компоненти.

Робота викладена на 36 сторінках, зокрема, містить 22 рисунків, 4 таблиці, список використаних джерел із 24 найменувань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ФЕРОМАГНІТНІ ПЛІВКОВІ НАНОСИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ОСАДЖЕННЯ, ФАЗОВИЙ СТАН, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА

3MICT

c.

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЕМ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ
СТРУКТУРИ І ФАЗОВОГО СКЛАДУ ФЕРОМАГНІТНИХ
ПЛІВКОВИХ НАНОСТРУКТУР (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД)7
1.1. Конструкція та принцип роботи просвічуючого електронного мікроскопа. 7
1.2. Режими роботи ПЕМ 14
1.3. Використання методу ПЕМ при дослідженні феромагнітних плівкових
наноструктур17
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 22
2.1. Методика підготовки зразків для проведення електронно-мікроскопічних
досліджень
2.2. Методика дослідження структурно-фазового складу феромагнітних
плівкових наноструктур 24
РОЗДІЛ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Зародження електронної оптики відбулось в кінці 19 століття і пов'язане із створенням електронно-променевої трубки. У першій електронно-променевій трубці (німецький фізик К.Ф. Браун, 1897 р.) пучок електронів відхилявся магнітним полем. У 1899 році німецький фізик І.Э. Віхерт застосував магнітне поле котушки зі струмом для фокусування електронного пучка в електроннопроменевій трубці. Німецький учений Х. Буш в 1926 році дослідив рух електронів в магнітному полі котушки зі струмом і зробив висновок, що вона підходить для отримання достовірних електронно-оптичних зображень, а отже, є електронною лінзою. В майбутньому дослідження електронних лінз на основі котушок зі струмом створило підгрунтя для створення електронного мікроскопа та приладів, в яких формуються електронно-оптичне зображення тіл, що випускають заряджені частинки, або яким-небудь чином впливають на промені електроннів.

Просвічуюча електронна мікроскопія – сукупність методів дослідження за допомогою ПЕМ фазового складу та структур обєктів, а також електричних і магнітних полів шляхом пропускання через нього пучка електронів.

Електронна мікроскопія включає дослідження способів створення електронно-оптичних зображень, створення і удосконалення електронних мікроскопів і приставок до них, розробку методів підготовки зразків, а також аналіз ,одержуваної в ході мікроскопічних досліджень, інформації [1].

Метою даної роботи було дослідження кристалічної структури та фазового стану феромагнітних плівкових наноструктур, сформованих на основі пермалоєвого сплаву Ni₈₀Fe₂₀ та Au методами електронографії та просвічуючої електронної мікроскопії.

Результати даної роботи були представлені на Міжнародній науковій конференції «Фізика, електроніка, електротехніка ФЕЕ :: 2022» (м. Суми, 2022).

РОЗДІЛ 1

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЕМ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СТРУКТУРИ І ФАЗОВОГО СКЛАДУ ФЕРОМАГНІТНИХ ПЛІВКОВИХ НАНОСТРУКТУР (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД)

1.1. Конструкція та принцип роботи просвічуючого електронного мікроскопа

Перший просвічуючий електронний мікроскоп (ПЕМ) працював за наступним принципом: пучок електронів проходячи крізь об'єкт потрапляв на електромагнітну лінзу, яка створює збільшене зображення об'єкта. Основною характеристикою ПЕМ є висока роздільна здатність. Схема лінз оптичного мікроскопа еквівалентна оптичній схемі ПЕМ, у якому замість світлового електронний, а роль оптичної системи лінз виконує система променя електронних лінз. Досліджуваний зразок повинен мати невелику товщину (менше 0,1 мкм), оскільки енергії пучка електронів повинно бути достатньо, щоб пройти через зразок та перенести інформацію на екран. До того ж ПЕМ використовує електрони високої енергії. Залежно від матеріалу, шо досліджують електрони прискорюють до кінетичних енергій в межах від КеВ до МеВ, що в свою чергу буде нагрівати зразок, поки він не буде зруйнований (руйнівний метод дослідження)[2].

Прилад ПЕМ-125К є стаціонарним електронним мікроскопом, який використовуюється для дослідження мікроструктури об'єктів, отримання дифракційних картин зразків, а також зображень зразків в широкому діапазоні збільшень при їх нахилі і обертанні [3].

Технічні характеристики ПЕМ-125К:

- 1) роздільна здатність по кристалічній решітці 0,2 нм;
- 2) роздільна здатність по точках 0,35 нм;
- 3) діапазон електронно-оптичного збільшення від 50 до 1300000;
- 4) ефективна довжина дифракційної камери від 80 до 3500 мм;

- 5) кут нахилу пучка (±4°);
- 6) прискорююча напруга від 25 до 125 кВ;
- 7) споживча потужність 5кВт;
- 8) залишковий тиск в колоні $1,2 \cdot 10^{-4}$ Па.



Рисунок 1.1 – Основні блоки ПЕМ-125К: 1 – станина, 2 – колона, 3 – система управління, 4 – система спостереження, 5 – система живлення, 6вакуумна система. Із роботи [3]

Мікроскоп ПЕМ-125К складається з масивної станини, необхідної для утримання інших блоків та гасіння зовнішніх вібрацій. На станині розташована колона . Для одержання пучка електронів і керування ним необхідне електричне живлення, що забезпечує система живлення. Система управління реалізована на комп'ютері. Вакуумна система забезпечує вакуум в колоні. Система спостереження слугує для одержання зображення досліджуваного зразка.

Колона представляє собою елемент електронної оптики і складається з двох частин. Верхня частина колони, що включає в себе електронно-променеву гармату, дві конденсорні лінзи та діафрагму формують систему освітлення. Електронно-променева гармата являє собою трьохелектродну систему, що складається з катода, анода та проміжного електрода. Між анодом і катодом прикладається висока напруга до 125 кВ, і електрони прискорюються до анода.



Рисунок 1.2 – Структурні елементи колони ПЕМ-125К: 1 - електроннопроменева гармата, 2 - конденсорні лінзи (а - конденсор 1, б - конденсор 2), 3 освітлювальна діафрагма, 4 - об'єктивна лінза, 5 - апертурна діафрагма, 6 селекторна діафрагма, 7 - три проміжні лінзи, 8 - проективна лінза, 9 - ручки важелі, 10 - камера спостережен

В центрі анода зроблений отвір, через який прискорені електрони пролітають крізь анод і попадають у колону [3].

Для первинного керування пучком між анодом і катодом є проміжний електрод, який збирає електрони в первинний пучок і регулює його діаметр, що впливає на яскравість. Перша конденсорна лінза - конденсор 1 відповідає за переміщення пучка, для чого використовується дві ручки "Переміщення" з лівого і правого боку від колони, які розміщені на станині. Конденсор 2 регулює діаметр пучка, що регулюється ручкою "Інтенсивність" рисунок 1.5 [4].

Друга, вона ж нижня, частина - система формування зображення. Освітлювальна діафрагма - молібденова пластина, в якій зроблено отвір діаметрами 30, 60, 90 мкм. Вона стає на шляху пучка і відповідно пропускає через себе електрони, які попадають в цей діаметр. Освітлювальна діафрагма відрізає повільні електрони, а в центрі залишаються електрони з однаковою



Рисунок 1.3 - Структурна схема електронно-променевої гармати: 1 - катод; 2 - проміжний електрод ; 3 - анод; 4 - пучок електронів; 5 - змінний резистор. Із роботи [3]



Рисунок 1.4 – Електромагнітні лінзи: електромагнітна лінза без полюсного наконечника (а) ; електромагнітна лінза з полюсним наконечником (б). Із роботи [3]

енергією, що прибирає спотворення зображення. В об'активну лінзу через шлюзову камеру за допомогою тримача вводиться зразок. Об'єктивна лінза сильна лінза, яка створює початкове збільшення зображення в декілька тисяч разів. В об'єктивну лінзу також вводиться апертурна діафрагма що представляє собою молібденову пластину, як і освітлювальна, але з отворами меншого діаметру. Апертурна діафрагма відсікає дифраговані пучки. Далі розташована селекторна діафрагма , яка вводиться для того, щоб обрати меншу площу зображення, при цьому зменшиться яскравість.

Наступними в колоні розташовані три проміжні лінзи . Для забезпечення збільшення до 10⁵- 10⁶ крат використовують слабкі лінзи, що розміщуються між



Рисунок 1.5 – Панелі керування ПЕМ-125К: Ліва панелі керування (а) ; права панель керування (б)

об'єктивом та проективом. Також їх використовують для повороту зображень. За проміжними лінзами йде сильна проективна лінза, збільшення якої не регулюється. Ручки важеля необхідні для переміщення зразка. Камера спостереження призначена для для спостереження збільшеного зображення структури зразка.

По обидва боки від колони розташувались понелі керування , розберемось з їх призначенням. Ручки "Переміщення" на лівій і правій панелі керування впливають на положення коденсорних лінз, що в свою чергу призводить до переміщення пучка електронів.

Ручкою "Інтенсивність", яка розміщена на лівій панелі керування регулюється діаметр пучка. Чим більший діаметр пучка, тим менша його яскравість. Ручками "Нахил" та "Обертання" (ручки гоніометра) у мікроскопі можливе переміщення зразка під електронним пучком, а також здійснюється його нахили. Ручка "Фокус" керує налаштуваннями об'єктивної лінзи, збільшує/зменшує різкість зображення. Ручки



Рисунок 1.6 – Еслементи вакуумної системи : 1 – шлюзова камера, 2 – магніторозрядний насос, 3 – дюар

"БФ"(багатофункціональна ручка) змінюють своє призначення залежно від режиму роботи ПЕМ. Ручки "Збільшення/Довжина камери" в режимі дифракції змінюють довжину камери і збільшують кратність зображення в інших режимах.

Зліва на колоні розташовано дюар, в який заливають рідкий азот, що необхідно для охолодження зразка. Магніторозрядний насос потрібен для створення вакууму в колоні. Шлюзова камера призначена для введення зразку для його подальшого дослідження.

Блок живлення, розташований окремо від станини, та необхідний для подачі живлення на всі інші системи електронного мікроскопа. Через систему керування, представлену в вигляді звичайного комп'ютера обладнаного спеціальним ΠО, здійснюється управління всіми конструктивними i мікроскопа. Під програмними елементами камерою спостереження розташовується фотокамера для реєстрації зображення на фотоплівці або фотопластинці . За своєю конструкцією фотокамери бувають: одно- або двохмагазинні.

На панелі індикації датчиків вакуума виведені дані подаються в мВ. Якщо показники датчиків знаходяться в червоній зоні (до 1,5 мВ), то система не готова до робити, бо магніторозрядний насос не вийшов в робочий режим. В



Рисунок 1.7 - Розміщення системи живлення, керування та реєстрації: блок живлення (а), комп'ютер (б), камера (в)



Рисунок 1.8 – Електронна система керування: 1 – датчики вакууму, 2 схема вакуумної системи, 3 - панель керування

залежності від ступеня вакууму датчики тиску починають загоратись синім кольором, тобто сигналізують про вихід насоса в робочий режим.

Схема вакуумної системи наочно демонструє стан кожного елементу шляхом світоіндекації, за допомогою цієї схеми можно відкривати і закривати клапани, вмикати і вимикати насоси, також міняти режим роботи системи з ручного на автоматичний і навпаки.

За допомогою панелі керування можна тонко налаштувати роботу в певному режимі, а також вибирати в якому саме режимі працювати. Кнопка

Column вмикає/вимикає живлення лінз, кнопка Hight tension - високу напругу, кнопка Flament - розжарення катоду. Перехід в режим дифракції здійснюється через кнопку D, а в режим мікродифракцій - M, також через цю панель вмикається режим світлого Bright і темного Dark поля. За допомогою кнопки Screen Up відбувається підняття предметного столика.

1.2. Режими роботи ПЕМ

Режим дифракції проявляється у формуванні на екрані електронного мікроскопу дифракційної картини від кристалічного об'єкту. При умові, що зразок достатньо тонкий, площа поперечного перерізу пучка рівна площі зразка, з якого утворюється дифракційна картина [5].

На дифракційній картині видно від 3 до 6 дифракційних кілець. Проте по останньому дифракційному кільцю не завжди можна з достовірними даними визначити параметр кристалічної гратки та дослідити фазовий склад зразка. Це пов'язано з тим, що відбувається обрізання внутрішніми отворами лінз частини електронного пучка [6]. Дифракційна приставка дає можливість виправити цей недолік, розмістивши зразок нижче проективної лінзи, необхідно здійснити нахил зразка відносно падаючого пучка, при цьому дослідження необхідно проводити в діапазоні температур зразка від -150 до 800 °C [3].

Режим мікродифракції - це дослідження обраної області дифракційної картини зразка. Під час проходження сфокусованим променем кристалічного



Рисунок 1.9 – Зовнішній вигляд дифракційної приставкию Із роботи [3]

зразка, електрони розсіюються відповідно закону Брега. Пучки, що розсіюються під кутом від <1 до 2° фокусуються об'єктивною лінзою, формуючи дифракційну картину в задній фокальній площині лінзи. Коли проміжна й проекційна лінзи налаштовані правильно, зображення в задній фокальній площині об'єктива проектує достовірну дифракційну картину на екрані. Саме селекторна діафрагма при мікродифракції дозволяє отримати електронограму від обмежених малою площею областей зразка.

Оптична сила проміжної лінзи зменшується ,поки зображення у задній фокальній площинні об'єктивної лінзи не сфокусується у площині зображення проміжної лінзи - за таких умов можна отримати мікродифракційну картину. Фактично проміжна лінза працює у режимі нульових збільшень [7].

Основними джерелами спотворення дифракційної картини при мікродифракції є сферична аберація та неправильне фокусування об'єктиву. Завдяки селекторній діафрагмі можна обирати ділянку для дослідження з мінімальними розмірами. Мінімальний можливий діаметр селекторної діафрагми - 5 мкм.

Режим роботи ПЕМ, в якому на екрані мікроскопа спостерігається збільшене зображення кристалічної структури об'єкта відповідає світлопольному



Рисунок 1.10 – Мікрознімок кристалічної структури Al в світлопольному (а) та темнопольному (б) режимах. Із роботи [2]

методу. На рисунку 1.10 показано зображення кристалічної структури плівки Аl, отримана в режимі світлого поля.

При роботі у цьому режимі, зображення створюється за рахунок пучка електронів, що пройшов, коли апертурна діафрагма відтинає дифраговані пучки. ПЕМ використовує всі лінзи колони, при чому освітлювальна та апертурна діафрагми введені в систему[3].

Зразок орієнтований так, щоб відбиття систематичної послідовності вищого порядку точно відповідали умовам дифракції. Зображення формується пучком електронів, який пройшов. Висока інтенсивність фону робить фокусування легким, при цьому час експозиції короткий, що зводе ризик погіршення роздільної здатності через механічну чи іншу нестабільність пристрою до мінімуму [8].

Другим конденсатором і струмом пучка регулюється яскравість зображення. Зображення фокусується об'єктивом. Збільшення здійснюється проміжною лінзою.

Режим темного поля — це режим спостереження за дифракцією електронів на кристалічному зразку. При вимкненні об'єктива або зміні фокуса на екрані з'являється дифракційна картина у вигляді світлих максимумів на темному полі. Це пояснюється тим, що атоми розташовані так, що кристал можна розглядати як просторову дифракційну решітку електромагнітних хвиль.

Режим темного поля реалізується на приладі ПЕМ-125К наступним чином: Ззмістити апертурну діафрагму так, щоб перекрити пройшовший пучок і відкрити шлях для дифрагованого пучка, тобто встановити апертурну діафрагму саме на шляху дифрагованого пучка. Нахилити освітлювальну систему таким чином, щоб пройшовший пучок відхилився на перний кут, а дифрагований став спрямований унапрямку оптичної осі.

Найпростіший спосіб отримати зображення в темному полі — розмістити апертурну діафрагми на шляху променя, але оскільки дифрагований промінь нахилений відносно осі лінзи, це суттєво обмежує роздільну здатність через сферичну аберацію. Тому використання діафрагми

зменшує роздільну здатність зображення. Через це застосовують нахил системи освітлення при роботі в режимі темного поля. Для спрощення роботи в режимі темного поля ПЕМ має систему відхилення електронного променя, яка дає результати, подібні до нахилу системи освітлення [9].

1.3. Використання методу ПЕМ при дослідженні феромагнітних плівкових наноструктур

Методи просвічуючої електронної мікроскопії та електронографії широко використовуться при дослідженні особливостей структурно-фазового стану одно- та багатокомпонентних плівкових матеріалів. Застосування даних методів дозволяє проаналізувати фазовий стан зразків свіжосконденсованих зразків та зміни у фазовому стані, які можуть виникнути внаслідок протікання конденсаційно-стимульованої дифузії під час осадження або термодифузії під час термообробки. Також використання електронографічного методу дозволяє проаналізувати зміни у фазовому стані зразків при зміні концентрації компонент у багатокомпонентних зразках. Аналіз кристалічної структури дозволяє провести комплексний аналіз електрофізичних чи магніторезистивних властивостей.

Так, наприклад у роботі [10] використовуючи метод просвічуючої електронної мікроскопії та електронографії було показано як змінюється фазовий стан та кристалічна структура плівок сплаву Ni_xFe_{1-x}/П у залежності від концентрації атомів Fe (рис. 1.11). Зокрема, було показано, що зразки товщиною 25 нм мають лабіринтну структуру, характерну для плівок феромагнітних металів. При цьому зразки при $c_{\text{Fe}} = 25$ і 50 ат.% мають двофазний склад: ГЦК-FeNi₃ (структурний тип Cu₃Au) у поєднанні з ГЦК-NiFe (структурний тип CuAu) відповідно з параметрами граток $a = 0,354 \pm 0,001$ нм. Збільшення концентрації атомів Fe до $c_{\text{Fe}} = 75$ ат.% спричиняє фазовий перехід і формування ОЦК-гратки з параметром $a = 0,286 \pm 0,001$ нм. Також авторами роботи [10] було встановлено, що в



Рисунок 1.11 - Кристалічна будова (а – г), електронограми (д – ж) плівок Fe_xNi_{1-x} із концентрацією c_{Fe} , ат.%: 25 (а, д), 50 (б, е), 64 (в, є) і 75 (г, ж) та спектр дифракції (з). Символами \blacksquare , \bullet , \blacktriangle та \lor позначені місцеположення дифракційних ліній, що відповідають табличним даним. Із роботи [10]



Рисунок 1.12 – Типові мікрознімки НЧ Fe₃O₄ (a) а CoFe₂O₄ (б) отримані методом просвічуючої електронної та дифракційні картина на вставках, отримані електронографічним методом для НЧ Fe₃O₄ та CoFe₂O₄. Із роботи [16]



Рисунок 1.13 – Мікрознімки кристалічної структури наноструктурованих зразків, сформованих на основі Со і Ад загальною товщиною *d* = 20 нм. Із роботи [17]



Рисунок 1.14 – Гістограми розподілу розміру гранул Со наноструктурованих зразків сформованих на основі Со і Ад загальною товщиною *d* = 20 нм. Із роботи [17]

деяких випадках (при $c_{\text{Fe}} = 75 \text{ ат.}\%$.) фіксується двофазний склад: ГЦК-FeNi + α -фаза (Fe Ni) (рис. 1.11). Разом з тим двофазний склад ГЦК-FeNi₃ + ГЦК-FeNi не спостерігався через різні температурні інтервали їх стабілізації [11]. До того зазначено, що вузька область гомогенності фаз FeNi₃ і FeNi сприяє появі кристалітів ОЦК-Fe із параметром гратки $a=0,284 \pm 0,002$ нм. Так зразки із концентрацією $c_{\text{Fe}} = 25$ і 50 ат.% мають двофазний склад, а саме ГЦК-FeNi₃ + ОЦК-Fe або ГЦК-FeNi+ ОЦК-Fe. При цьому концентрація зерен ОЦК-Fe є незначною. Аналогічну особливість спостерігали і автори роботи [12]. Автори робіт [13-15] аналізуючи фазовий стан плівкових сплавів Fe_xNi_{1-x}/П встановили, що при $c_{\text{Fe}} = 20-50$ ат.%, мають однофазний склад (ГЦК-FeNi₃ або ГЦК-FeNi). При цьому на формування фазового стану не пливає метод отримання зразків.

Автори роботи [16] використовуючи метод просвічуючої електронної мікроскопії отримала мікрознімки кристалічної структури для наночастинок Fe₃O₄ та CoFe₂O₄ виготовлених методом термолізу. Це дозволило визначити форму досліджуваних наночастинок та встановити їх середній розмір, що має принципове значення при аналізу їх магнітних та властивостей.

Автори роботи [17], аналізуючи результати електронно-мікроскопічних досліджень наноструктурованих зразків, сформованих на основі Со і Ад (рис. 1.13) встановили, як залежить середній розмір гранул та як змінюється їх розподіл за розмірами (рис. 1.14) у залежності від концентрації атомів Со в системі. Так, було показано, що гранули Со при $c_{Co} = 17$ ат.% мають середній розмір L = 4-13 нм, а при $c_{Co} = 42$ ат.% їх середній розмір зростає до L = 5-27 нм. Прицьому відбувається зменшення відстані між ними. Подальше збільшення c_{Co} до 60 ат.%супроводжується зростання розкиду гранул за розмірами (L = 3-31 нм), а при $c_{Co} = 81$ ат.% відбувається утворення суцільної феромагнітної плівки [17].

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

2.1. Методика підготовки зразків для проведення електронномікроскопічних досліджень

Перш за все, до початку проведення будь-яких досіджень зі зраками необхідно привести самі зразки до належного стану, щоб мати коректні результати дослідження. Підготовку зразків до мікроскопічних досліджень фактично можно розділити на два основних етапи. Перший – підготовка підкладки до осадження на неї зрака. Важливий етап, так як від правильності виконання дій під час цього етапу залежить якість нанесеня і рівномірність розподілу осаджуваної речовини. Процедура підготовки підкладки виглядає наступним чином – на кристали КСL осаджують плівку вуглицю з графітового стержня, далі сіль з тонкою вуглецевою плівкою за допомогою пінцету поміщають в деіонізовану воду з невеликою кількістю ацетону так щоб КСL ростворився в воді, а плівка плавала на її поверхні. За допомогою пінцету і



Рисунок 2.1 – Підготовка підкладки до осадження на неї зразка: 1 - графітовий стержень; 2 - кристали КСL; 3 - вуглецева плівка; 4 - мідна сітка покрита вуглецевою плівкою

мідної сітки виловлюють вуглицеві плівки з води так щоб вона рівномірно нанеслась на сітку і не пошкодилась при цьому. Другий етап - електроннопроменеве осадження зрака на підкладку - є основнивним в підготовці зразка до мікроскопічних досліджень, так як саме на цьому етапі ми формуємо зразок до того стану в якому помістимо його в колону мікроскопа перед безпосереднім досліджування.

Зразки осаджувалися у вакуумній камері ВУП-5М за допомогою методики олночасної конденсації методом електронно-променевого випарування при кімнатній температурі та тиску залишкових газів 10⁻⁴ Па (рис. 2.2). Швидкість конденсації складала 3-5 нм/хв. Конденсація проводилося на мікроскопічні сіточки з попередньо нанесеними плівками вуглецю для структурно-фазового стану зразків. Схема дослідження розміщення електронно-променевих гармат у вакуумній камері приладу представлена на рисунку 2.3. Наважки Ni₈₀Fe₂₀ та Au розташовувалася безпосередньо на анодах електронно-променевих гармат, які бомбардувалися електронами, що емітували з катодів під дією напруги 1 кВ [18]. Осадження проводилося за температури підкладки $T_{\rm n}$ = 300К. Контроль товщини кожного шару (з точністю до 10%)



Рисунок 2.2 – Схема робочої камери установки ВУП-5М: 1 – тримач підкладок, 2 – електронно-променеві гармати; 3 – робоча камера, 4 - кварцеві резонатори



Рисунок 2.3 – Електронно-променева гармата: 1 – корпус; 2вольфрамовий анод із наважкою; 3 – катод; 4 – керамічна ізоляція

проводився за допомогою системи із двох незалежних кварцевих резонаторів. Використовувалися кварцові пластини РГ-08 з резонансною частотою 6 МГц, стабілізоване джерело живлення Б5-50, приладами для вимірювання частоти Ф5035 або Ч3-34А [19].

За описаною вище методикою була отримана серія феромагнітних нанорозмірних плівкових систем (Ni₈₀Fe₂₀ + Au)/П загальною товщиною 45 нм. На прикладі зразка з концентрацією атомів Au $c_{Au} = 30$ ат.% буде проведено дослідження структурно-фазового стану з використанням методів електронографії та просвічуючої електронної мікроскопії. Також для коректного аналізу фазового стану зразків після конденсації були окремо отримані плівкові зразки компонентів системи Ni₈₀Fe₂₀(45)/П та Au(45)/П (в дужках товщина вказана у нм) та проведено аналіз їх структурно-фазового стану.

2.2. Методика дослідження структурно-фазового складу феромагнітних плівкових наноструктур

Методику дослідження фазового складу можна умовно розділити на два етапи. Перший етап - отримання електронограми дифракційним методом на ПЕМ-125К (рис. 2.4). Другий етап - розшифровка електронограми шляхом використання п'яти фундаментальних рівнянь електронографії [20].

Співвідношення 2.1 пов'язує кут розсіювання з міжплощинними відстанями та довжиною хвилі (закон Бреггів):

$$2d_{hkl} \cdot \sin \Theta = n \cdot \lambda \quad (2.1)$$

де d_{hkl} - міжплощинна відстань (hkl – індекси Міллера); n – порядок відбиття хвилі (в електронографії n=1); Θ – кут відбиття; λ – довжина хвилі.

Співвідношення 2.2 пов'язує сталу приладу з діаметром дифракційних кільця. Через те, що кути Θ приблизно дорівнюють (2 – 4), можна записати $tg 2\Theta \cong \sin 2\Theta \cong 2\Theta = D/2L$. Із (2.3) визначаємо 2 Θ як відношення $2\lambda/2d_{hkl} = \lambda/d_{hkl}$. Звідси:

$$D/2L = \lambda/d_{hkl}$$
 also $D \cdot d_{hkl} \cong 2L \cdot \lambda$ (2.2)

Величина $2L \cdot \lambda = C$ - :

$$C = 2L \cdot \lambda = (D \cdot d_{hkl}) \tag{2.3}$$

Сталу приладу визначають за допомогою електронограми від еталонного зразка з відомими міжплощинними відстанями (це плівки Al, Au, Ag, NaCl, TlCl, MgO). Знаючи *C*, ми можемо знайти *d*_{hkl} для невідомого зразка та визначити параметри решітки та її тип [20].

Для визначення стала приладу потрібно визначити діаметри кілець на електронограмі еталону ,як можно точніше (±0,1 мм). Для розрахунків електронограм від невідомого зразка необхідно скористатися 2.4, 2.5 та 2.6 співвідношеннями. Третім рівнянням може бути квадратична форма, яка у випадку кубічної сингонії має такий вигляд [20]:

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a_{hkl}^2}$$
(2.4)



Рисунок 2.4 - Зовнішній вигляд приладу ПЕМ-125К (а) та скріншоти програми при роботі в режимі дифракція (б) та режимі великих збільшень (б)

3 2.4 випливають 2.5 і 2.6 рівняння електронографії

$$\frac{1}{d_{h1k1l1}^2} : \frac{1}{d_{h2k2l2}^2} : \frac{1}{d_{h3k3l3}^2} : \dots = (h_1^2 + k_1^2 + l_1^2) : (h_2^2 + k_2^2 + l_2^2) : (h_3^2 + k_3^2 + l_3^2) : \dots (2.5)$$

$$a_{hkl} = d_{hkl} \cdot \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$
(2.6)

Дослідження кристалічної структури зразка відбувається в режимі великих збільшень (т.зв. «світле поле»). У цьому режимі, зображення формується пройшовшим променем електронів, коли апертурна діафрагма відтинає дифраговані пучки. У мікроскопі задіюються всі лінзи колони, введені апертурні та освітлювальна діафрагми.

РОЗДІЛ З

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дослідження фазового стану та кристалічної структури феромагнітних плівкових наноструктур та їх складових компонент, проводяться з метою комплексного аналізу ïχ фізичних властивостей (електрофізичних, електромеханічних, магнітооптичних, магніторезистивних тощо). У випадку феромагнітних плівкових наноструктур періодичного типу (багатошарові мільтишари, спін-вентельні та структури) аналіз процесів структури фазоутворення дозволить отримати додаткову інформація про стан меж подіту, т.зв. інтерфейсів, а саме про їх стабільність чи навпаки не стабільність. У випадку структур, сформованих методом одночасної конденсації (гранульовані методу просівічуючої електронної структури, композити) за даними мікроскопії можна судити про середній розмір зерен компонент систем. Особливо це важливо з точки зору аналізу магніторезистивних властивостей феромагнітних багатокомпонентних матеріалів. Також застосування методі просвічуючої електронної мікроскопії та електронографії дозволяють вплив умов осадження (температура підкладки, швидкість визначити осадження, ступінь вакууму) на фазовий стан та кристалічну структуру зразків.

Саме це була обумовлена мета даної роботи, яка полягає у дослідження кристалічної структури та фазового стану феромагнітних плівкових наноструктур, сформованих на основі пермалоєвого сплаву Ni₈₀Fe₂₀ та Au методами електронографії та просвічуючої електронної мікроскопії.

Для коректного аналізу фазового стану зразків після конденсації додатково було проведено аналіз структурно-фазового стану одношарових плівок Ni₈₀Fe₂₀(45)/П та Au(45)/П (в дужках товщина вказана у нм).

За методикою описаною у розділі 2, спочатку було проведено визначення сталої приладу. Еталонним зразком була обрана плівка Al, яка забезпечує точність ± 0,001 нм [20]. На рисунку 3.1 представлена типова дифракційна картина віл плівки Al(50)/П, а результати розрахунку сталої приладу за

співвідношенням (2.4) зведені у таблиці 3.1.

На рисунки 3.1-3.3 представлені мікрознімки кристалічної структури та дифракційні картини для зразків Au(45)/П, Ni₈₀Fe₂₀(45)/П та (Ni₈₀Fe₂₀+Au)/П при $c_{Au} = 30$ ат.% і d = 45 нм відповідно. Результати розрахунку електронограм зведені у таблицях 3.1-3.3.

Проаналізуємо спочатку мікрознімки кристалічної структури та дифракційні карти для складових компонентів (Au(45)/П, Ni₈₀Fe₂₀(45)/П) досліджуваного зразка (Ni₈₀Fe₂₀+Au)/П при $c_{Au} = 30$ ат.% і d = 45 нм. Дифракційні дослідження одношарових плівок Au, показали, що їх фазовий



Рисунок 3.1 – Дифракційна картина від плівки Al (*d* = 30 нм)

N⁰	<i>D</i> , мм			hkl	$d_{ m hkl}$, нм	$C=D\cdot d$, мм·Å	
	D_1	D_2	$D_{ ext{cep}}$				
1	161	163	162	111	0,2338	37,875	
2	187	188	187,5	200	0,2038	38,212	
3	265	265	265	220	0,1432	37,942	
4	310	312	311	311	0,1221	37,973	
C= 38,002 мм·Å							

Таблиця 3.1 – Визначення сталої приладу

 D_1 та D_2 – діаметри кілець у двох взаємно перпендикулярних напрямках



Рисунок 3.2 – Дифракційні картина (на вставці) та кристалічна структура від плівки Au(45)/П після конденсації

Таблиця 3.2 – Розшифровка дифракційної картини плівок Au(45)/П після конденсації

Плівка	N⁰	$d_{ m hkl}$, нм	hkl	фаза	$a_{ m hkl},{ m HM}$	d ⁰ _{hkl} ,нм [21]
	1	0,2361	111	ГЦК-Аи	0,4089	0,235
	2	0,2029	200		0,4058	0,203
Au	3	0,1439	220		0,4070	0,1439
	4	0,1233	311		0,4089	0,1227



Рисунок 3.3 – Дифракційна картина (на вставці) та кристалічна структура від плівки Ni₈₀Fe₂₀(45)/П після конденсації

Таблиця 3.3 – Розшифровка дифракційної картини плівок Ni₈₀Fe₂₀(45)/П після конденсації

Плівка	N⁰	$d_{ m hkl}$, нм	hkl	фаза	$a_{ m hkl},$ HM	d ⁰ _{hkl} ,нм [22]
	1	0,204	111	ГЦК-Ni₃Fe	0,3533	0,2044
	2	0,1761	200		0,3522	0,1772
NicoFeco	3	0,1251	220		0,3538	0,1253
141801 020	4	0,1066	311		0,3535	0,1069



Рисунок 3.4 – Дифракційні картина та кристалічна структура від плівки $(Ni_{80}Fe_{20} + Au)/\Pi$ загальною товщиною 45 нм при $c_{Au} = 30$ ат.%

Таблиця 3.3 — Фазовий склад зразка (Ni₈₀Fe₂₀+Au)/П загальною товщиною d = 45 нм після конденсації

N⁰	$d_{ m hkl}$,нм	hkl	фаза	$a_{ m hkl}$,HM	d ⁰ _{hkl} , нм [21, 22]	
1	0,2350	111	ГЦК-Аи	0,4070	0,235	
2	0,2038	111	ГЦК-Ni₃Fe	0,3529	0,2044	
_		200	ГЦК-Аи	0,4076	0,203	
3	0,1779	200	ГЦК-Ni₃Fe	0,3558	0,1772	
4	0,1435	220	ГЦК-Аи	0,4058	0,1439	
5	0,1258	220	ГЦК-Ni₃Fe	0,3558	0,1253	
6	0,1228	311	ГЦК-Аи	0,4072	0,1227	
\overline{a} (ГЦК-Ni ₃ Fe) =0,3548 нм; a_0 = 0,3545 нм.						
\overline{a} (ГЦК-Аи) = 0,4069 нм; a_0 = 0,4078 нм.						

склад відповідає ГЦК-Аи із середнім параметром гратки \bar{a} (Au) = 0,4076 нм, що відповідає табличним значенням для масивних зразків a_0 (Au) = 0,4078 нм (табл.. 3.2). Аналіз мікрознімків кристалічної структури (рис. 3.2) показав, що плівка Au крупнокристалічна, середній розмір кристалітів становить L = 30 нм. Середній розмір кристалітів визначався за співвдношенням $L_{cep} = \frac{N_1 \cdot L_1 + N_2 \cdot L_2 + ... + N_n \cdot L_n}{N_1 + N_2 + ... + N_n}$, де $L_{i(i=1, 2..., n)}$ – розмір кристалітів, який визначався за допомогою програмного забезпечення Altami Studio; N_i – кількість кристалітів [20].

Електронографічні дослідження зразка Ni₈₀Fe₂₀(45)/П показали, що плівка має ГЦК-гратку (рис. 3.3), а параметр гратки становить величину \overline{a} (ГЦК-Ni₃Fe) = 0,3532 нм (табл. 3.3), що відповідає даним для масивного матеріалу a_0 (Ni₃Fe) =0,3545 нм. Кристалічна структура зразка дрібнодисперсна, лабіринтна, з середнім розміром зерна L = 5 нм. Така структура характерна для плівок феромагнітного пермалоєвого сплаву Ni₈₀Fe₂₀ [21].

Аналіз електронограм системи (Ni₈₀Fe₂₀+Au)/П свідчить про наступне. Поперше, на електронограмі фіксуються лінії, що належать двом ГЦК граткам (рис. 3.4). Розшифровка електронограм (табл. 3.4) показала, що ці лінії належать ГЦК-Ni₃Fe та ГЦК-Au, що відповідає фазовому стану складових компонент системи. Розрахунки параметрів граток ($a(\Gamma \amalg K-Au) = 0,4078$ нм та $a(\Gamma \amalg K-Ni_3Fe) = 0,3548)$ свідчить про відповідність параметрам граток для його складових компонент та табличним даним. Слід також відмітити, що ліній з міжплощинними відстанями Аналізуючи розподіл інтенсивностей ліній на електронограмах слід зазначити, що лінії d200(Ag) і d111(Ni3Fe) та d311(Ag) і *d*₂₂₀(Ni₃Fe) фактично співпадають, ЩО призводить до перерозподілу інтенсивностей на дифракційній картині.

Аналізуючу кристалічну структуру зразка (Ni₈₀Fe₂₀+Au)/П, що вона є нанорозмірною з середнім розміром зерна L = 10-12 нм. Внаслідок реалізацію методу одночасні конденсації відпивається сповільнення росту зерен немагнітної компоненти[24].

ВИСНОВКИ

1. Метод просвічуючої електронної мікроскопії може бути реалізований за допомогою просвічуючого електронного мікроскопу ПЕМ-125К. Розглянуто конструкцію та принцип роботи структурних елементів даного приладу, а також порядок роботи з використанням спеціального програмного забезпеченні до нього. Визначені особливості роботи на даному приладі в режимі «дифракція» та «світле поле»..

2. Метод просвічуючої електронної мікроскопії у поєднанні з методом електронографії широко використовуться при дослідженні особливостей структурно-фазового стану одно- та багатокомпонентних плівкових матеріалів, визначити характер розподілу зерен магнітної компоненти у немагнітній матриці, визначити форму наночастинок та встановити їх середній розмір.

3. Використовуючи метод просвічуючої елетронної мікроскопії та електронографії було проведено дослідження структурно-фазового стану одношарових плівок Ni₈₀Fe₂₀(45)/П та Au(45)/П та сформованої на їх основі феромагнітної нанорозмірної плівкової системи (Ni₈₀Fe₂₀ + Au)/П з концентрацією атомів Au $c_{Au} = 30$ ат.%.

4. Фазовий склад феромагнітної нанорозмірної плівкової системи (Ni₈₀Fe₂₀ + Au)/П є двофазним та відповідає ГЦК-Ni₃Fe + ГЦК-Au із параметрам ґратки $a(\Gamma$ ЦК-Ni₃Fe) = 0,3548 нм та $a(\Gamma$ ЦК-Au) = 0,4069 нм, що відповідає комбінації фаз складових компонент системи. Перерозподіл інтенсивностей на електронограмі відбувається внаслідок накладання ліній d_{200} (Ag) і d_{111} (Ni₃Fe) та d_{311} (Ag) і d_{220} (Ni₃Fe).

5. Кристалічна структуру зразка (Ni₈₀Fe₂₀+Au)/П є нанорозмірною з середнім розміром зерна L = 10-12 нм. Це пов'язано з тим що внаслідок реалізацію методу одночасні конденсації відбувається сповільнення росту зерен немагнітної компоненти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- <u>https://www.docsity.com/ua/elektronniy-mikroskop/1111820/</u> Зародження електронної оптики (дата доступу 14.05.2022 р.).
- Lyashenko O.A. Using the Scanning Electron Microscopy for diagnostics of a surface of semiconductors: ehe graduation research, 2003. – 43 p.
- Проценко І.Ю., Чорноус А.М., Проценко С.І. Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів / За загальною редакцією проф. І.Ю. Проценка: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 264 с.
- Гірін О.Б., Овчаренко В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу «Прикладний електронно-мікроскопічний аналіз матеріалів» з дисципліни «Прикладне матеріалознавство» для студентів IV курсу механічного факультету та факультету КН та І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 с.
- Бутенко Т.І., Колінько С.О., Ващенко В.А. Конспект лекцій з дисципліни «Контроль структури, елементного та фазового складу матеріалів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями галузі знань 13 "Механічна інженерія" денної форми навчання. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 75 с.
- 6. Пазуха І.М., Степаненко А.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електронна та іонна оптика» /– Суми: Вид-во СумДУ, 2012. 31 с.
- Загородній В.В.Локальні методи досліджень: підручник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» /; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, - 323 с.
- 8. Grimley E.D., LeBeau J.M. Transmission Electron Microscopy (STEM and TEM), 2019. P. 1-13.
- 9. <u>https://studfile.net/preview/9264363/page:9/</u> Режими роботи ПЕМ-125К (дата доступу 18.05.2022 р.)
- 10. Тищенко К.В. Електромеханічні властивості плівкових матеріалів на основі

магнітних металів : дис. на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.07 – Фізика твердого тіла. – Суми : СумДУ, 2018. – 150 с.

- Бібик В.В., Гричановська Т.М., Проценко І.Ю. Електрофізичні властивості плівкових систем на основі Ni та Fe // Металлофиз. Новітні технології. – 2005. – Т. 27, № 6. – С. 775 – 784.
- 12. A study on electrodeposited Ni_xFe_{1-x} alloy films / M. Bedir, O.F. Bakkaloglu,
 I.H. Karahan [et al.] // Pramana J. Phys. –2006. V. 66. P. 1093 1104.
- Sim G.-D., Vlassak J.J. High-temperature tensile behavior of freestanding Au thin films // Scripta Mater. – 2014. – V. 75. – P. 34 – 37.
- Xiang Y., Vlassak J.J. Bauschinger and size effects in thin-film plasticity // Acta Mater. – 2006. – V. 54. – P. 5449 – 5460.
- 15. Mechanical properties of electrodeposited permalloy thin film measured by using a tensile test / X. Li, G. Ding, H. Wang [et al.] // Book of abstract 14th international solid-state sensors, actuators and microsystems conference [«Transducers 2007 »]. – 2007. – P. 555.
- Synthesis of core/shell spinel ferrite/carbon nanoparticles with enhanced cycling stability for lithium ion battery anodes / Yun-Ho Jin, Seung-Deok Seo, Hyun-Woo Shim [et al.] // Nanotechnology. 2012. V.23, №12. P.125402–1 125402–6.
- 17. Influence of the magnetic field on the structural characteristics of granular CoxAg100-x thin film alloys / I.O. Shpetnyi, V.Ya. Pak [et al.] // Thin Solid Films. – 2021. – V. 724 – P. 138613-1 – 138613-8.
- Структурно-фазовий стан, магніторезистивні та магнітні властивості плівок пермалою / Я. М. Литвиненко, І. М. Пазуха, О. В. Пилипенко [та ін.] // Металлофиз. новейшие технол. – 2015. – Т. 37, №10. – С.1001 – 1017.
- Тищенко К.В., Чешко І.В. Моделювання тензорезистивних властивостей плівкових матеріалів // Матеріали міжнародної наукової конференції «Моделювання – 2010». – Київ, 2010. – С. 229 – 234.
- 20. Технологія одержання і фізичні властивості плівкових матеріалів та основи

мікроелектроніки (практикуми): навчальний посібник / І.Ю.Проценко, Л.В.Однодворець. - Суми: Сумський державний університет, 2020. – 231 с.

- 21. Грінченко В.Ф., Митрохин О.В., Грінченко О.В. Кристалографія», частина 2. – К.: Вид-во «Київський університет», 1999 - 48 с.
- 22. Gasior W., Moser Z., Debski A. Heat of formation of FeNi70, FeNi73. 5 and FeNi80 ordered alloys from the homogenous region of the FeNi3 phase // J. Alloy. Compd. 2009. V.487. V.132. P.132-137.
- 23. Structural-phase state, magnetoresistive and magnetic properties of permalloy films / Ia.M. Lytvynenko, I.M. Pazukha, O.V. Pylypenko [et al.] // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2015. – V.37, №10. – C.1377 –1393.
- 24. Жаботинський В.І., Логвинов А.М., Пазуха І.М. Структурно-фазовий стан нанорозмірних плівкових систем на основі пермалоєвого сплаву Ni₈₀Fe₂₀ та Au // Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка ФЕЕ :: 2022». – Суми: Сумський державний університет, Суми, 2022. – С. 34.